

	<h2 style="color: red;">FDP023N08B-F102</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP023N08B-F102</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP023N08B-F102.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 194 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDP023N08B-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	194 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.35 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	245W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP023N08B_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13765pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 245W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDP023N08B-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP023N08B-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP023N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDP023N08B-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP020N06B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP020N06B FAIRCHI FDP020N06B FAIRCHI</p>	 <p>FDP020N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>
 <p>FDP023N08B FAIRCHI FDP023N08B FAIRCHI</p>	 <p>FDP020N06BH FAIRCHILD FDP020N06BH FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N06B FAIRCHI FDP027N06B FAIRCHI</p>	 <p>FDP025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP023N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP023N08B-F102 Datenblatt	FDP023N08B-F102-Datenblätter	FDP023N08B-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP023N08B-F102
FDP023N08B-F102 Electronic	FDP023N08B-F102-Komponenten	FDP023N08B-F102-Verteiler	FDP023N08B-F102-Bild	FDP023N08B-F102-Teil
FDP023N08B-F102 Preis	FDP023N08B-F102 Hersteller	FDP023N08B-F102 Bild	FDP023N08B-F102 Aktie	FDP023N08B-F102 Inventar
FDP023N08B-F102 Neu	FDP023N08B-F102 Original	FDP023N08B-F102 garantiert	FDP023N08B-F102 RFQ	FDP023N08B-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited